



티타늄 박막을 이용한 자동차 타이어 압력센서

Automotive Tire Pressure Sensors with Titanium Membrane

채 수*

오산대학교 자동차계열

Soo Chae*

Department of Automobile Engineering, Osan University, Osan 447-749, Korea

[요약]

본 연구에서는 강한 내구성을 지닌 자동차 타이어용 압력센서를 개발하기 위해 박막 물질로서 적용될 티타늄 멤브레인의 기계적 특성이 연구되었다. 제작공정으로 기존의 마이크로 머시닝공정과 적층 공정기술이 동시에 적용되었으며, 티타늄 멤브레인 기반의 압력 센서가 설계, 제조 및 특성화 되었다. 마이크로 머시닝 공정을 통한 티타늄 멤브레인과 기판의 접합 제조과정은 30분 동안의 20 MPa의 압력과 200°C의 온도과정 후 24°C에서의 냉각으로 진행된다. 각각의 압력센서 표면은 니켈 도금된 후방전극이 기판 위에 마이크로 소자로 조립되었다. 제작과정에서 발생한 잔류응력을 예측하기 위해 유한요소 해석이 적용되었다. 또한 티타늄 멤브레인의 외부 압력하에서 변형에 의한 처짐이 계산되었다. 제작된 장치의 민감도는 10.15 ppm kPa⁻¹ 였고 이때의 정전용량 변화량은 0.18 pF, 압력 범위는 0-210 kPa 였다.

[Abstract]

In this work, mechanical characteristics of titanium diaphragm have been studied as a potential robust substrate and a diaphragm material for automotive tire pressure sensor. Lamination process techniques combined with traditional micromachining processes have been adopted as suitable fabrication technologies. To illustrate these principles, capacitive pressure sensors based on titanium diaphragm have been designed, fabricated and characterized. The fabrication process for micromachined titanium devices keeps the membrane and substrate being at the environment of 20 MPa pressure and 200°C for a half hour and then subsequently cooled to 24°C. Each sensor uses a stainless steel substrate, a laminated titanium film as a suspended movable plate and a fixed, surface micromachined back electrode of electroplated nickel. The finite element method is adopted to investigate residual stresses formed in the process. Besides, out-of-plane deflections are calculated under pressures on the diaphragm. The sensitivity of the fabricated device is 9.45 ppm kPa-1 with a net capacitance change of 0.18 pF over a range 0-210 kPa.

Key Words: Capacitance, Finite Element Method, Micromachining, Pressure Sensor, Titanium

http://dx.doi.org/10.14702/JPEE.2014.105



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/

licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Received 5 November 2014; **Revised** 14 November 2014 **Accepted** 20 November 2014

*Corresponding Author

E-mail: schae@osan.ac.kr

I. 서론

미세가공(Micromachining)기술은 반도체 가공기술(IC Processing Technology)에서 시작되어 실리콘 기판상에서 미 세 기계요소 즉 밸브, 모터, 펌프, 기어 등의 부품을 2차원 평 면으로 제작한 것이 그 시초였으며, 1970년대 이후 표면 미 세가공(surface micro machining) 기술과 벌크 미세가공(bulk micro machining) 기술의 등장으로 실리콘 기판을 기반으 로 한 3차원 구조물을 제작하게 되었다[1-5]. 실리콘 기반 의 마이크로 구조물 제작 시. 외부환경에 의한 부식 및 노이 즈(noise)로 부터 구조물을 보호하기 위해 패키징(packaging) 을 하게 되지만[6.7], 패키징에 따른 비용이 마이크로 구조 물 제작에 드는 비용과 비슷한 수준이거나 더 많음으로 인 해 가격상승의 원인이 된다. 만약 외부환경의 영향에 대하 여 강한 재료를 직접 구조물이나 기판의 재료로 사용할 수 있게 된다면 패키징 공정을 간소화 시키거나 생략할 수 있 게 되어 가격절감의 효과를 가져올 수 있을 뿐 아니라 우주 나 바다와 같은 거친 환경에 응용될 수 있다. 미세가공기술 을 이용해 마이크로 요소 시장에 소개된 압력센서의 종류에 는 크게 두 가지가 있다. 첫 번째는 정전용량 효과(Capacitive effect)를 이용하여 압력을 측정하는 것이고, 두 번째는 압저 항 효과(Piezoresistive effect)를 이용한 것이다. 두 가지 종류 모두 많이 이용되었으나. 높은 측정 민감도와 낮은 전력손실. 높은 안정성으로 인해 정전용량 효과를 이용한 압력센서가 더 많이 소개되었다[8-10]. 그러나 초소형 정전용량 압력센 서를 상용화하기 위해서는 외부 잡음(noise)이나 기생정전용 랑(Parasiticcapacitances)과 같은 기생효과를 효과적으로 완 화시켜야 하며, 이를 위해 센서부와 리드아웃 칩을 식각과정 을 통해 연결하여 하나의 기판 안에 집적시켜 회로부와 센서 부를 통합해야 한다. 이러한 집적화 과정을 통해 기생효과를 줄일 수 있을 뿐 아니라. 버퍼링(buffering)을 높이고 정전용 량을 주파수나 전압으로 변환시켜주는 효과를 얻을 수 있다.

본 논문에서는 박막 및 기판의 재료로 티타늄을 사용하여 외부환경에 강한 마이크로 정전형 압력센서를 제작하였다. 제작 공정으로 미세 기계가공 기술과 마이크로 직접회로 제작공정이 사용되었으며, 공정 후의 박막과 기판 모두 별도의 패키징 없이 외부환경에 노출되었다. 제작된 배열형 압력센서의 압력에 따른 정전용량이 실험적 방법에 의해 측정되었으며, 제작 공정에서 발생하는 박막의 잔류응력을 해석하기 위해 유한요소 해석을 하였다. 또한, 잔류응력(Residual stress)이 고려된 박막의 외부 압력에 따른 처짐 량을 이론적으로 제시하고, 수치적 해석과 실험을 통해 검증하였다.

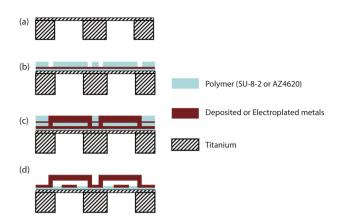


그림 1. 티타늄 멤브레인이 적용된 압력센서의 제작과정 Fig. 1. Fabrication sequence of pressure sensor based on titanium diaphragm.

Ⅱ. 제작 공정

티타늄을 박막과 기판 재료로 사용하여 마이크로 압력센 서를 제작하는 과정을 그림 1에 나타내었다. 기판(substrate) 을 제작하기 위해 한 변의 길이가 6 cm, 높이 0.8 mm, 표면 거칠기가 약 6-8 μm 인 정사각형 티타늄 기판에 미세가공 과정을 통해 6×6 배열형태로 중심과 중심의 간격이 7 mm인 직경 2 mm의 구멍을 만든다. 냉간압연(cold rolled)을 통 해 제작된 상용 티타늄 박판(Precision Brand Product, INC) 을 제작된 티타늄 기판 위에 얹고 프래스(Hot press)를 이용 하여 접합시킨다. 사용된 박막의 두께는 각각 12.7 μm, 25.4 μm 이며, 표면 거칠기는 약 1000 Å이다. 접합을 위해 에폭시 레진(EIS epoxy laminate prepreg no.106)이 사용되며, 압력 판이 8.65 Mpa의 압력으로 박막과 기판을 30분 동안 압착시 킨다. 그 후 이온반응식각(RIE: Reactive ion etching)을 통해 압착과정에서 외부로 새어 나온 에폭시 레진을 제거한다(그 림 1(a)). 박막과 기판이 일체형으로 완성되면 박막 위에 표 면 미세가공 공정과 벌크 미세가공 공정을 통해 감지부(sensor part)로 사용될 구조물을 형성하게 된다. 박막 위에 점착 층(adhesion layer)으로 사용될 티타늄(Ti)을 250 Å두께로 증 착시키고, 그 위에 절연충(insulation layer)으로 사용될 7 μm 두께의 에폭시 레진 SU-8-2 (MicroChem Corp.)를 증착시킨 다. 바닦 전극과 전기도금 씨드층(electroplating seed layer), 그리고 접합패드(bonding pad)를 만들기 위해 Ti/Cu/Ti 를 250/6000/250 Å두께로 에폭시 레진 위에 증착시키고 준비 된 마스크(mask)를 이용해 패턴을 형성하여 AZ4620 감광제 (photoresist: Clariant Corp.)층을 약 25-27 μm두께로 쌓는다 (그림 1(b)), 패턴된 감광제 층을 통해 전기도금 몰드(mold)가

만들어진다. 센서부로 사용될 구조물을 제작하기 위해 씨드 층으로 Ti/Cu/Ti 을 증착시킨다. 그 위에 약 25 µm두께로 감광제 층을 쌓고, 전기도금 몰드로 사용될 패턴을 형성시킨다. 이 몰드안에 전기 도금 방식으로 니켈을 채운다(그림 1(c)). 마지막으로 구조물과 박막 사이의 감광제 희생층(sacrificial layer)과 구조물 외부에 있는 씨드층을 제거하여 완성한다.

III. 이론적 모델

정전 압력센서는 외부에서 압력이 가해질 때 박막의 처짐이 발생하여 박막과 구조물 사이의 간격이 변하게 되고, 이에 따른 정전용량의 변화를 통해 가해진 압력을 측정하게 된다. 티타늄 박막의 처짐 량과 정전용량을 해석하기 위한 개념도를 그림 2에 나타내었다. 그림에서 보는 것과 같이 박막은 외부에서 가해지는 압력에 의해 거동하게 된다. 여기서 t_g 는 박막과 센서판(backplate)사이의 초기 간격을 나타내고, t_m 은 박막의 두께, w_0 는 박막 중앙에서의 처짐 량을 나타낸다. 이론적 모델을 구성하기 위해 제안된 가정은 다음과 같다. (a)박막은 기계적으로 등방성 물성치를 가지고 있다. (b)박막 위에 증착된 전극(electrode)의 두께는 박막의 두께에 비해때우 작으므로 해석 시 무시되었다. (c)박막과 센서판(backplate)사이의 간격이 측면방향의 길이보다 작으므로 전기장이 옆으로 휘는 프린징 효과(fringing effect)는 무시되었다.

이러한 조건에서 원형박막의 처짐을 반지름 r에 대한 함수 w(r)로 나타내면 다음과 같다[11,12].

$$w(r) = w_0 \left[1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right]^2 \tag{1}$$

여기서 w_0 는 박막 중앙 부분의 처짐 량을 나타내며 다음 식에 의해 구해진다.

$$\frac{Pa^4}{Et_m^4} = \frac{16}{3(1-\mu^2)} \frac{w_0}{t_m} + \frac{7-\mu}{3(1-\mu)} \frac{w_0^3}{t_m^3}$$
 (2)

E는 박막의 Young's modulus이고, μ 는 박막의 Poisson's ratio이다. 단, 처짐 량이 박막의 두께에 비해 적을 경우 다음 식에 의해 구해진다.

$$w_0 = \frac{Pa^4}{64D} \tag{3}$$

식 (3)에서 P는 외부에서 가해지는 압력이며, a는 기판 구 명(hole)의 반지름, D는 $Et^3_m/12(1-\mu^2)$ 으로 표시되는 박막의 flexural rigidity이다. 제작 공정에서 발생하는 잔류응력을 고려한 박막의 처집 량을 구하는 식은 다음과 같다[13].

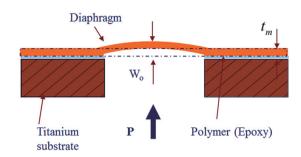


그림 2. 티타늄 박막 및 기판의 단면 개념도

Fig. 2. A schematic cross-section of a titanium diaphragm and substrate.

$$w(r) = \frac{Pa^2}{4\sigma_i t_m} \left[1 - \left(\frac{r}{a}\right)^2 \right], \quad \left(\sigma_i \neq 0\right)$$
 (4)

여기서 σ_i 는 제작공정 중 발생된 잔류응력, t_m 는 박막의 두 m, r은 박막 중앙부분으로부터 떨어진 거리를 나타낸다. 위의 식은 박막의 처짐 량이 박막의 두께에 비해서 작을 때 적용 가능한 식으로 Bromley 가 제시한 식의 고차 항을 무시함으로 얻어진다[13].

모델링 과정에서 전기장의 프린징 효과가 무시된다고 가 정되었으므로 전기장은 센서판의 면에 대하여 수직방향으로 흐른다. 이때 정전용량은 박막의 형상함수 w(r)에 대하여 표현할 수 있다.

$$C_s = \varepsilon_0 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r dr \frac{r}{t_g - w(r)}$$
 (5)

IV. 박막의 처짐 측정 및 유한요소 해석

배열형 정전용량 압력센서에서 센서 각각의 처짐 특성을 기술하기 위해 Keithley 3322 LCZ 미터를 사용하여 측정하였다. 우선, 제작된 압력센서를 상용 압력센서(Fluke Corp. PV 350 Digital Pressure/Vacuum Module)와 디지털 멀티미터 (Digital multimeter)가 연결된 고정구에 설치한 후 밀봉하고, 압력원(pressure source)으로 사용될 압축된 질소 가스 관을 조절기(regulator)와 함께 고정구에 연결시켜 압력의 변화를 조절한다. 그후 LCZ 미터를 제작된 압력센서에 연결시켜 정전용량 압력센서의 특성 데이터를 얻는데 사용한다. 정전용량 값을 얻은 후, 박막 위에 전기도금 된 NiFe를 제거하여 외부에 노출된 박막을 현미경 스테이지(stage)에 놓는다. 고정구를 통해 압력을 가한 후, 현미경을 통해 박막의 처짐을 관

107 http://JPEE.org

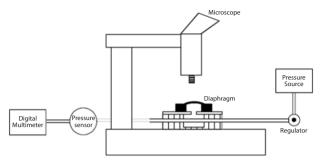


그림 3. 박막의 처짐 측정 장비 구성 개념도

Fig. 3. Optical diaphragm deflection measurement setup.

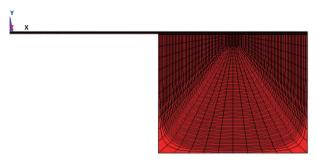


그림 4. 티타늄 압력센서의 2차원 유한요소 축대칭 모델 Fig. 4. 2-D axisymmetric FE model of the titanium pressure sensor.

찰하고, z-축 마이크로 미터(micro meter)를 이용해 박막 의처짐 량을 측정한다. 위의 과정에 사용된 실험 장비 구성을 그림 3에 나타내었다.

스테인리스 강 박막과 기판을 접합하는 공정에서 압력 판에 의해 가해진 열과 압력에 의해 박막에 잔류 응력이 발생하게 된다. 발생하는 잔류응력을 풀림처리(annealing)하여 제거할 수 있으나 풀림 온도가 400℃이상의 고온이어서 접착층의 손상 등 부작용이 발생하게 되므로 발생마이크로 구조물에 적용하기는 적합하지 않다. 그리하여 공정 중 발생하는 잔류응력에 의한 박막의 변형 량을 해석하여 설계에 반영해야 한다.

접합 과정 중에 발생하는 잔류응력의 양과 박막의 처짐 량을 유한요소모델을 통해 해석 하였다.제작 과정 중, 유한요소 모델 형성 및 해석을 위해 ANSYS를 사용하였으며 8850개의 요소와 8724개의 절점으로 모델링 되었다. 그림 4는 유한요소 해석 시 사용된 축 대칭 모델(axisymmetric model)로, 박막과 기판 모두 스테인리스 강 재질을 적용하였으며 센서 판(backplate)과 박막 위의 전극은 생략되었다. 박막과 기판 의 두께는 각각 12.7 μm, 0.8 mm이고 박막과 기판 사이의 접착 층(bonding layer)은 에폭시 수지(epoxy resist)로 7 μm 두

께이다. 구속조건으로는 박판과 기판의 외곽을 r, Z방향으로 모두 구속시켰다.

프레스를 이용해 박막과 기판을 접합하는 과정에서 발생하는 잔류응력을 해석하기 위해 적용된 외부 압력과 온도는 8.65 MPa, 175℃-25℃ (냉각)로 실제 제작에서와 동일한 조건을 가하였으며, 완성된 정전용량 압력센서 박막의 처짐을 해석하기 위해 기판의 2 mm 구멍을 통해 티타늄 박막에 가해지는 압력범위는 0-210 kPa이다. 모든 해석에 접합 층으로 사용된 에폭시 수지를 고려하였으며, 공정 과정에서 압력과 온도가 가해지는 시간이 30분이므로, 시간에 따른 잔류응력을 해석하기 위해 과도해석(transient analysis)을 수행하였다.

V. 연구 결과

제작된 압력센서의 압력에 따른 정전용량과 처집량 및 기계적 특성에 영향을 미치는 잔류응력에 대한 해석결과를 나타내었다. 그림 5는 유한요소 해석에 의해 얻은, 초기 30분동안 티타늄 박막에 형성되는 잔류응력을 보여준다. 0-2분이내에 잔류응력이 300 MPa이상으로 형성되고 30 분이 되기까지 조금씩 낮아지지만, 큰 변화량 없이 그 값이 유지됨을 알수 있다. 해석 결과로, 30분이 되었을 때의 잔류응력 값은 329 MPa이며 잔류응력으로 인해 박막 중앙 부분에 처집량은 약 4.5 µm이다. 그림 6은 식 (2)를 통해 얻은 박막의 처점에 대한 이론 값과 실험을 통해 얻은 값을 비교하여 나타낸 그래프이다.

이론 값과 실험 값 사이에 많은 차이가 발생하였음을 볼수 있다. 그러나 그림 5에서 유한요소 해석을 통해 구한 잔류 응력 값을 식 (4)에 적용하여 얻은 박막의 처짐 량을 실험을 통해 얻은 처짐 량과 비교한 결과 거의 일치함을 알 수있었다

그림 7에 잔류응력을 고려하여 얻은 이론 값과 실험에 의해 얻은 값을 비교하여 나타내었다. 그림 8은 실험에서 얻은처짐 량과 식 (4)를 통해 잔류응력을 고려한 이론 값, 그리고유한 요소 해석을 통해 얻은 값을 서로 비교하여 나타낸 그래프이다. 유한요소 해석 결과가 실험결과와 이론 결과에 유사함을 나타낸다

VI. 결론

이제까지 실리콘 기반이 주류를 이루었던 마이크로머시 닝 공정을 스테인리스 강과 같은 외부 환경에 강한 재료로

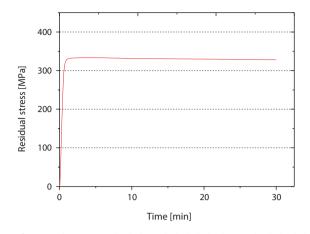


그림 5. 초기 30분 동안 티타늄 압력센서의 잔류응력 해석 결과 Fig. 5. Result of the residual stress analysis of the titanium diaphragm during 30 minutes.

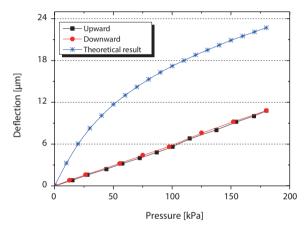


그림 6. 티타늄 박막의 잔류응력을 고려하지 않은 이론적 결과 와 실험결과 비교

Fig. 6. Comparison of the deflection of titanium diaphragm with non-residual stress effect theory.

대체 할 수 있게 될 때, 제작공정의 단순화와 패키징 공정의 간소화를 이루게 되어 제작비용의 절감에 기여할 수 있게 된 다. 또한, 공정비용을 최소화 하기 위해서는 마이크로머시닝 공정을 통해 제작된 박막 구조물의 거동특성을 미리 예측해 야 하며, 이것을 위해 이론 식을 통해 예측한 결과와 유한요 소 해석을 통해 예측한 결과가 실제 실험에 대하여 얼마만큼 의 신뢰성을 갖는지는 중요한 설계요인이 된다.

본 연구에서는 티타늄 박막과 기판을 이 용하여 배열형 정 전용량 압력센서를 제작하였다. 미세 기계가공 공정과 마이 크로머시닝 공정을 통해 기판과 박막을 제작하였으며, 센서 부와 회로부가 통합된 압력센서를 제작하였다. 제작 공정에

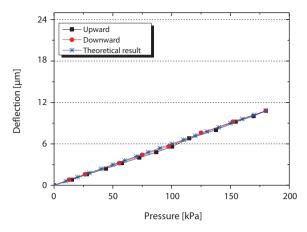


그림 7. 티타늄 박막의 잔류응력을 고려한 이론적 결과와 실험 결과 비교

Fig. 7. Comparison of the deflection of titanium diaphragm with residual stress effect theory.

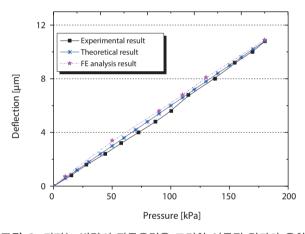


그림 8. 티타늄 박막의 잔류응력을 고려한 이론적 결과와 유한 요소 해석결과 비교

Fig. 8. Comparison of the deflection of titanium diaphragm with residual stress effect theory and FE analysis. result.

서 발생하는 잔류응력은 약 329 MPa 로, 유한요소법을 통해 해석되었다. 또한, 박막의 처짐을 수학적으로 예측하기 위해 잔류응력을 고려해야 함을 실험과 수치적 해석을 통해 밝혀 냈다.

참고문 헌

- [1] H. Baltes, "CMOS micro electro mechanical systems," *Sensors and Materials*, vol. 9, pp. 331-346, 1997.
- [2] N. C. MacDonald, "SCREAM microelectro mechanical

109 http://JPEE.org

- systems," *Microelectronic Engineering*, vol. 32, pp. 49-73, 1996.
- [3] D. I. Choi, K. J. Jeon, and S. W. Lee, "Surface micromachining techniques," *Journal of Mechanical Science and Technology*, vol. 37, No. 12, pp. 73-77, 1997.
- [4] R. T. Howe, "Applications of silicon micro machining to resonator fabrication," in *Proceeding of 1994 IEEE International Frequency Control Symposium*, Boston: MA, pp. 2-7, 1994.
- [5] C. H. Mastrangelo, X. Zhang, and W. C. Tang, "Surface micromachined capacitive differential pressure sensor with lithographically-defined silicon diaphragm," in *Pro*ceeding of International Solid-State Sensors and Actuators Conference, vol. 1, pp. 612-615, 1995.
- [6] R. R. Tummala, Fundamentals of Microsystems Packaging. New York, NY: McGraw-Hill, 2001.
- [7] S. J. Stein, R. Wahlers, M. Heinz, and M. A. Stein, "Thick film heaters made from dielectric tape bonded stainless steel substrates," in *Proceeding of ISHM '95*, pp. 125-129, 1995.

- [8] G. T. A. Kovacs, Micromachined Transducers Sourcebook. New York, NY: McGraw-Hill, 1998.
- [9] W. P. Eaton and J. H. Smith, "Micromachined pressure sensors: Review and recent developments," *Smart Materials and Structures*, vol 6, pp. 530-539, 1997.
- [10] G. S. Chung, K. C. Lee, and J. H. Lee, "Fabrication of a micromachined ceramic thin-film type pressure sensor for high over pressure tolerance and its characteristics," *Journal of the Korean Physical Society*, vol. 49, no. 4, pp. 1379-1383, 2006.
- [11] S. Timoshenko, *Theory of Plates and Shells*. New York, NY: McGraw-Hill, 1940.
- [12] W. H. Ko, M. H. Bao, and Y. D. Hong, "A high-sensitivity integrated-circuit capacitive pressure transducer," *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 29, pp. 48-56, 1982.
- [13] E. I. Bromley, J. N. Randall, D. C. Flanders, and R. W. Mountain, "A technique for the dertermination of stress in thin films," *Journal of Vacuum Science & Technology B*, vol. 1, no. 4, pp. 1364-1366, 1983.



채 수 (Soo Chae)_종신회원

1998년 2월 : 중앙대학교 기계공학과 일반대학원(공학박사) 1996년 3월 ~ 2006년 7월 : 군장대학교 디지털자동차과 교수

2008년 3월 ~ 현재 : 오산대학교 자동차계열 교수

〈관심분야〉 자동차공학, 자동차전기전자 및 전자제어, 기계공학, 열유체해석